

POWER SWITCHING TRANSISTORS N-P-N LEISTUNGS-SCHALTTRANSISTOREN N-P-N

Type	Maximum ratings ● Grenzdaten						I_{CBO}	at	U_{CB}	h_{21E}	at	U_{CB}	$-I_E$	f	t_f	$U_{BE\ sat}$	$U_{CE\ sat}$	Case Gehäuse
Typ	U_{CBO}	U_{CEO}	I_C	U_{EBO}	P_{tot}	ϑ_j	$I_{CES\ max}$	bei	U_{CES}^*	bei	U_{CE}^*	I_C^*	f_T^*	μs	U_{BE}^*	$U_{CE\ max}$		
	V	V	A	V	W	°C	mA	V		V	A	MHz		V	V			
KU601	60	50	3	3	10 ⁴)	155	0,3	60	\cong 20	6	1	30 \cong 15		1,0 ³)*	1 ¹)	T35		
KU602	120	80	3	3	10 ⁴)	155	0,3	120	\cong 20	12	0,5	30 \cong 15		1,0 ³)*	1 ¹)	T35		
KU605	200	80	10	6	50 ⁵)	155	1	50	50 \cong 10	1,7*	8	\cong 0,5	2,4 ²)	1,7 ²)	T37			
KU606	120	60	8	6	50 ⁵)	155	1	50	50 \cong 10	10	0,5	\cong 5	\cong 0,5	2,4 ²)	2,45 ²)	T37		
KU607	210	80	10	5	70 ⁵)	155	1	150	50 \cong 10	2,45*	8	\cong 5	\cong 0,5	2,4 ²)	1,7 ²)	T37		
KU608	250	80	10	5	70 ⁵)	155	1	150	50 \cong 10	10	0,5	26 \cong 9	\cong 0,5	2,4 ²)	1,7 ²)	T37		
KU611	60	50	3	3	10 ⁴)	155	0,05	50	90 \cong 20	1,7*	8			1,0 ⁷)*	1 ¹)	T32		
KU612	120	80	3	3	10 ⁴)	155	0,05	50	90 \cong 20	10	0,5	30 \cong 15		1,0 ⁷)*	1 ¹)	T32		
										6	1	30 \cong 15						
										12	0,5	30 \cong 15						
										6	1	30 \cong 15						
										12	0,5	30 \cong 15						

1) $I_C = 1\text{ A}$, $I_B = 0,1\text{ A}$ 2) $I_C = 8\text{ A}$, $I_B = 0,8\text{ A}$ 3) $U_{CB} = 6\text{ V}$, $-I_E = 1\text{ A}$ 4) $U_{CE} \leq 30\text{ V}$, $\vartheta_c \leq 75\text{ °C}$ 5) $U_{CE} \leq 20\text{ V}$, $\vartheta_c \leq 35\text{ °C}$ 6) $U_{CE} \leq 20\text{ V}$, $\vartheta_c \leq 45\text{ °C}$ 7) $U_{CB} = 6\text{ V}$, $-I_E = 0,2\text{ A}$

DataSheet4U.com

DataShee

DUAL TRANSISTORS N-P-N DOPPEL-TRANSISTOREN N-P-N

Type	Maximum ratings ● Grenzdaten						I_{CBO}	at	U_{CB}	h_{21E}	at	U_{CB}	$-I_E$	Case Gehäuse
Typ	U_{CBO}	U_{CEO}	U_{EBO}	I_C	P_C 1)	ϑ_j	$I_{CBO\ max}$	bei	U_{CB}	bei	U_{CB}	$-I_E$		
	V	V	V	mA	mW	°C	nA	V		V	V	mA		
KC510	45	30	5	100	450	175	10	30	50 ... 500	10	0,1	T25		

1) Both systems, without cooling ● Beide Systeme, ohne Kühlung

DataSheet4U.com